SOD-323 Schottky Barrier Diode 肖特基势垒二极管

■ Internal Configuration& Device Marking 内部结构与产品打标

Type 型号	RB751V-40
Pin 管脚	 
Mark 打标	5

■Absolute Maximum Ratings 最大额定值

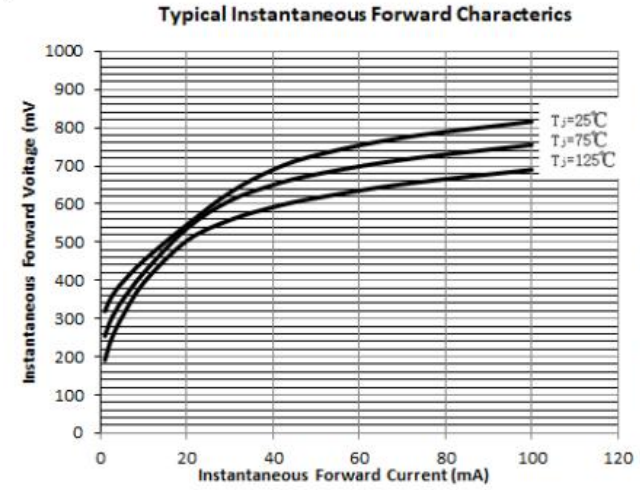
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Peak Reverse Voltage 反向峰值电压	V_{RM}	40	V
DC Reverse Voltage 直流反向电压	V_R	30	
Forward Work Current 正向工作电流	I_O	30	mA
Peak Forward Surge Current 正向峰值浪涌电流	I_{FSM}	200	mA
Power dissipation 耗散功率	P_D(Ta=25℃)	200	mW
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	500	℃/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J,T_{stg}	-55to+125℃	

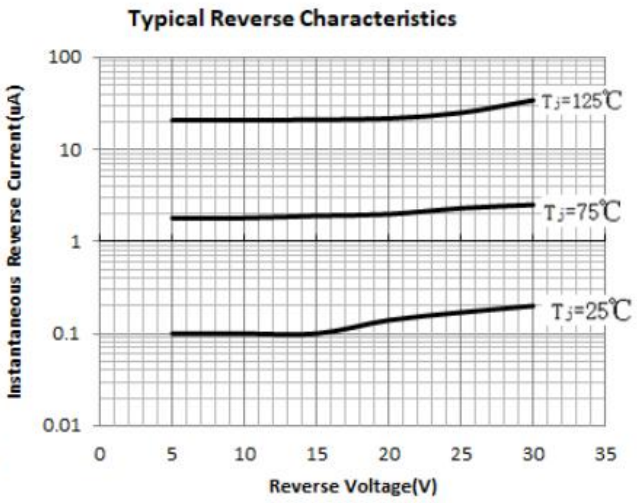
■Electrical Characteristics 电特性

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明，温度为 25℃**)**

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压(I_R=0.1mA)	$V_{(BR)}$	40	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏电流(V_R=30V)	I_R	—	0.5	μA
Forward Voltage 正向电压(I_F=1mA)	V_F		0.37	V
Diode Capacitance 二极管电容(V_R=1V, f=1MHz)	C_D	—	10	pF
Reverse Recovery Time 反向恢复时间	T_{rr}	—	5	nS

■Typical Characteristic Curve 典型特性曲线





■Dimension 外形封装尺寸

Symbol	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.600	1.800	0.063	0.071
B	1.200	1.400	0.047	0.055
C	0.750	0.950	0.030	0.037
C1	0.450	0.550	0.018	0.022
D	2.450	2.800	0.096	0.110
L	0.200	0.400	0.008	0.016
b	0.200	0.400	0.008	0.016
h	0.020	0.120	0.001	0.005
Θ3	0°	8°	0°	8°

